## 电磁场易错点和重点分析

## 易错点

- 1. 求力要写方向,虚功原理
- 2. D2n-D1n=σ 注意在φ时的正负号, n由1到2
- 3. 概念, 理想导体, 良导体, 不良导体, 理想介质
- 4. 铁磁材料的μ才很大,像Cu等物μ都是μ0的
- 5. 铁磁材料u非线性
- 6. 内自感
- 7. 互感方向性问题, 正负号
- 8. 注意en x (H2-H1) = Ku 这样子的方向, 叉乘涉及到方向的都要小心
- 9. A矢量的边界条件要小心, 要我说就干脆点都按照B来画不会错的
- 10. 注意一定要注意垂直于纸面方向的厚度长度等, 经常搞掉
- 11. 高频情况, 趋肤效应, 电容外电感不变, 内电感可能因为磁链k变而变
- 12. 注意有限差分法
- 13. 区别好介质结论

$$q' = rac{arepsilon_1 - arepsilon_2}{arepsilon_1 + arepsilon_2} q, \quad q'' = rac{2arepsilon_2}{arepsilon_1 + arepsilon_2} q$$
 вний  $I'' = rac{\mu_1}{\mu_1 + \mu_2} I = rac{1}{\mu_1 + \mu_2} I$  в развидения образования обра

- 14. Cu的µ约等于µ0
- 15. 注意气隙的个数, 数清楚
- 16.  $D2n-D1n=\sigma J2n-J1n=-dq/dt H2t-H1t = Ku$
- 17. w=2pi f (不知道是不是只有我会笔误写成2pi/f)
- 18. 注意电感互感同名端的位置和方向

## 注意点

- 1. 部分电容的概念
- 2. 两介质,等效电荷(静电场),等效电流(恒定磁场),波的正入射(时变场)
- 3. 恒定电场的静电比拟
- 4. 概念,磁化电流以长直螺线管为例: 介质磁化以后,由于分子磁矩的有序排列,其宏观效果是在介质横截面边缘出现环形电流,这种电流称为"磁化电流"(Is)。 磁化电流与传导电流的区别 磁化电流是分子电**流规则排列的宏观反映,并不**伴随电荷的定向运动,不产生热效应。 而传导电流是由大量电荷作定向运动而形成的。
- 5. 磁矢位磁标位定义和运用,注意库伦规范,注意磁障碍面
- 6. 用A算磁通量,记着长直导线ρ>a时A=μ0I/2pi\*ln(a/ρ),可以通过对B积分求得
- 7.  $\nabla \times \nabla \times A = \nabla(\nabla \cdot A) \nabla^2 A$
- 8. 从能量角度算互感
- 9. 有限差分法
  - 1. 差分计算思想和原理
  - 2. 泊松方程的差分代数方程
  - 3. 第一二类边界条件的差分方程
  - 4. 迭代方法解方程的原理公式
  - 5. 差分法求解Laplace方程的流程
- 10. 几类问题, 主要指数理方程的第几类边界, 即数值, 偏分, 数值+偏分
- 11. 不同介质分界面上静电场衔接条件, E不同的主要原因是极化电荷op不同

12.

## 重点

- 1. 波阻抗的概念
- 2. 电磁场能量密度
- 3. 坡印亭矢量的意义
- 4. 内自感千万别忘,长直圆柱导线的内自感和导线半径无关,单位长度的内自感为µ/8pi
- 5. 麦克斯韦方程三种形式和其物理意义

6. 
$$\begin{cases} \nabla^2 \dot{E} + \omega^2 \mu \varepsilon_c \dot{E} = 0 \\ \nabla^2 \dot{H} + \omega^2 \mu \varepsilon_c \dot{H} = 0 \end{cases}$$
 矢量形式的赫姆霍兹方程

7. 
$$\begin{cases} \nabla^2 \varphi - \mu \varepsilon \, \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon} \\ \nabla^2 A - \mu \varepsilon \, \frac{\partial^2 A}{\partial t^2} = -\mu J_{\rm ext} \end{cases}$$
 达朗贝尔方程,消除了w

欸有点厉害,注意这里是洛伦兹规范,

$$\begin{cases} \boldsymbol{E} = -\frac{\partial \boldsymbol{A}}{\partial t} - \nabla \boldsymbol{\varphi} \\ \boldsymbol{B} = \nabla \times \boldsymbol{A} \end{cases}$$

- 8. 趋肤深度 $d=1/sqrt(pif\mu\gamma)$ ,注意其是通过良导体的波动方程求出来的,为实部 $\alpha$ 的倒数,进而改变交流阻抗
- 9. TEM TE TM 截止波数
- 10. 波阻抗 E  $sqrt(\epsilon) = H sqrt(\mu)$ ,则Z=E/H= $sqrt(\mu/\epsilon)$  TEM波Kc=0

TEM可以理解成ΤΕ或ΤΜ带入Γ是满足的

TM波和TE波波阻抗 $K_c^2=w^2\mu\epsilon_c+\Gamma^2$   $j^2w^2\mu\epsilon_c=(jK_c)^2+(-\Gamma)^2$  这个更为本质 空间约束波形+传播约束=总的

TM 
$$\frac{\dot{E}_{0*}}{\dot{H}_{0*}} = -\frac{\dot{E}_{0*}}{\dot{H}_{0*}} = \frac{\Gamma}{j\omega\varepsilon_{*}}$$
 磁场是平面的,E是存在纵向的

TE 
$$\frac{\dot{E}_{0x}}{\dot{H}_{0x}} = -\frac{\dot{E}_{0y}}{\dot{H}_{0x}} = \frac{j\omega\mu}{\Gamma}$$
  $\nabla$ 

11. 交流情况下就用εc可以减少很多问题,比如算介质直接的关系,把γ这玩意直接换算掉 12.